(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2003-168810 (P2003-168810A)

(43)公開日 平成15年6月13日(2003.6.13)

(51) Int.Cl.7		識別記号	FΙ		Ť	~~7J~h*(参考)
H01L	31/04		B 0 5 B	1/14	Z	4D075
B05B	1/14		B 0 5 D	7/00	Н	4 F 0 3 3
B 0 5 D	7/00		H01L	21/225	R	5 F O 5 1
H01L	21/225			31/04	Α	

審査請求 未請求 請求項の数4 OL (全 6 頁)

弁理士 深見 久郎

特願2001-366940(P2001-366940)	(71)出願人	000005049	
		シャープ株式会社	
平成13年11月30日(2001.11.30)		大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号	
	(72)発明者	今中 崇雄	
		大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号	シ
		ャープ株式会社内	
	(74)代理人	100064746	
		平成13年11月30日(2001.11.30) (72)発明者	ジャープ株式会社 平成13年11月30日(2001.11.30) 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 (72)発明者 今中 崇雄 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 ャープ株式会社内

最終頁に続く

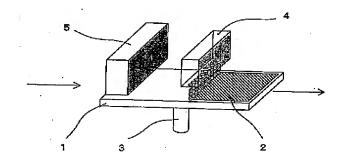
(54) 【発明の名称】 太陽電池の製造装置および製造方法

(57)【要約】

【課題】 安定したドーパント液の塗布を可能とし、粘度の低いドーパント液を用いることができる太陽電池の製造装置および製造方法を提供する。

【解決手段】 インクジェット方式によって基板上にドーパント液を塗布する手段を備えた太陽電池の製造装置であって、ドーパント液を塗布する際のドーパント液の粘度 n (N s / m^2)が 0 . 0 0 1 (N s / m^2)以上であるときのインクジェットヘッドのノズル径 d (μ μ) が下記式

30-1000×n≤d≤34-1000×n にて規定される太陽電池の製造装置である。また、上記 製造装置を用いて、基板上にドーパント液を塗布する工 程を含んでいる太陽電池の製造方法である。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 インクジェット方式によって基板上にド ーパント液を塗布する手段を備えた太陽電池の製造装置 であって、ドーパント液を塗布する際のドーパント液の 粘度n (Ns/m²)が0.001 (Ns/m²)以上で あるときのインクジェットヘッドのノズル径d(μm) が下記式

 $30-1000\times n \le d \le 34-1000\times n$

にて規定されることを特徴とする太陽電池の製造装置。

液の粘度n(Ns/m²)が0.001以上0.02未 満 (Ns/m^2) であることを特徴とする請求項1に記 載の太陽電池の製造装置。

【請求項3】 ドーパント液を基板上に塗布するインク ジェットヘッドと、基板を保持し基板を進行させる基板 チャックと、基板の外形寸法を測定してインクジェット ヘッドにその情報を伝達する基板形状測定装置とを具備 することを特徴とする請求項1または2に記載の太陽電 池の製造装置。

【請求項4】 請求項1から3のいずれかの項に記載の 20 太陽電池の製造装置を用いて、基板上にドーパント液を 塗布する工程を含むことを特徴とする太陽電池の製造方 法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、太陽電池の製造装 置および製造方法に関し、特にインクジェット方式によ って基板上にドーパント液を塗布する太陽電池の製造装 置および製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】図5から図7を参照して、従来の太陽電 池の製造工程の一例を説明する。ここで、基板11はp 型多結晶シリコン半導体角型基板が用いられている。

【0003】図5(a)において、まず、基板11製造 時に生じる表面の加工変質層を除去するため、あるいは 異方性エッチングによって基板11の表面に微細なピラ ミッド状の凹凸を含むテクスチャ表面を形成するため、 水酸化ナトリウムを含む溶液中に浸漬することでエッチ ング処理を行なう。

【0004】次に、図5(b)に示すように、リン等の 40 拡散源を含むドーパント液12を基板11上に塗布す る。

【 0 0 0 5 】 従来、このドーパント液塗布工程は以下に 説明するスピン塗布法を用いていた。スピン塗布法は、 まず図6に示されているように静止した基板11の中央 部に一定量のドーパント液12が吐出され、次に図7で 示されているように基板11を約5000rpmで高速 回転させ、テクスチャ表面が形成された基板11の受光 面上全体にドーパント液12を均一に広げる方法であ る。

【0006】しかし、スピン塗布法は基板11の回転の 加減速に時間を要するという問題があった。また、回転 モーメントにより、特に多結晶基板の場合には基板11 の割れが生じ易く歩留まりが低下するという問題もあっ た。さらに、スピン塗布法は基板11上に塗布されたド ーパント液12が基板11の側面および裏面に回り込 み、無駄になる割合が多いという問題もあった。

【0007】このようなスピン塗布法の問題を解決する ため、インクジェット方式によってドーパント液を塗布 【請求項2】 ドーパント液を塗布する際のドーパント 10 する方法がある。たとえば特開2000-183379 公報において、太陽電池の製造にジェットプリンタを用 いる方法が開示されている。また特開2000-133 649公報において、絶縁膜の形成にインクジェット方 式を用いる方法が開示されている。また特開平11-2 51259号公報において、半導体層への不純物の導入 にインクジェット方式を用いる方法が開示されている。 さらに特開平9-141876号公報において、プラス チック、金属またはガラスに印刷する方法としてインク ジェット方式を用いる方法が開示されている。

> 【0008】しかしながら、特開2000-18337 9公報および特開2000-133649公報および特 開平11-251259号公報においてはインクジェッ トヘッドノズル径とドーパント液の粘度との関係につい ては記載されておらず、塗布ムラのない安定したドーパ ント液の塗布をすることができないことがあった。

【0009】また、特開平9-141876号公報にお いては、インクジェットヘッドノズル径とドーパント液 の粘度について記載されているが、インクジェットヘッ ドノズル径が50~200μmと大きく、かつドーパン ト液の粘度も0.02~0.2(Ns/m²)と大きい ため、生産性向上の観点から速乾性が要求され、粘度の 低いドーパント液を用いる太陽電池の製造にはこの技術 は不適であった。

[0010]

【発明が解決しようとする課題】上記事情に鑑みて、本 発明は、塗布ムラのない安定したドーパント液の塗布を 可能とし、かつ粘度の低いドーパント液を用いることの できる太陽電池の製造装置および製造方法を提供するこ とを目的とする。

【0011】

【課題を解決するための手段】本発明のインクジェット 方式によって基板上にドーパント液を塗布する手段を備 えた太陽電池の製造装置は、ドーパント液を塗布する際 のドーパント液の粘度 $n(Ns/m^2)$ が 0.001 (Ns/m^2) 以上であるときのインクジェットヘッド のノズル径 d (μm) が下記式

 $30-1000\times n \le d \le 34-1000\times n$ にて規定されることから、塗布ムラのない安定したドー パント液の塗布を可能とし、かつ粘度の低いドーパント

50 液を塗布することができる。

3

【0012】ここで、ドーパント液を塗布する際のドー パント液の粘度n(Ns/m²)が0.001以上0. O2未満(Ns/m²)であることが好ましく、ドーパ ント液を基板上に塗布するインクジェットヘッドと、基 板を保持し基板を進行させる基板チャックと、基板の外 形寸法を測定してインクジェットヘッドにその情報を伝 達する基板形状測定装置とを具備していることが好まし 11

【0013】また、本発明による太陽電池の製造方法 は、上記太陽電池の製造装置を用いて、基板上にドーパ 10 電素子板8の駆動を制御することによって行なわれる。 ント液を塗布する工程を含むことを特徴としている。

[0014]

【発明の実施の形態】以下、図面を参照しつつ、本発明 の好ましい実施の形態について説明する。

【0015】<太陽電池の製造装置>図1は、本発明の 太陽電池の製造装置の一例を模式的な斜視図で表わして いる。図1において、1は基板、2はドーパント液、3 は基板チャック、4はインクジェットヘッド、5は基板 形状測定装置を示している。

【0016】ここで基板1は基板チャック3によって保 20 持されており、この基板1上には基板形状測定装置5お よびインクジェットヘッド4が設置されている。また、 基板形状測定装置5とインクジェットヘッド4は基板1*

*の進行方向に沿ってこの順序に並んでいる。

【0017】<インクジェットヘッドノズル径とドーパ ント液粘度との関係>図2はインクジェットヘッド4の 模式的な断面図を表わしている。図2において、6はノ ズル、7はインキチャンバ、8は圧電素子板を示してい る。ここで、上記ドーパント液2の塗布は、インキチャ ンバ7中に注入されたドーパント液2がノズル6から吐 出されることにより行なわれ、この吐出は基板形状測定 装置5から送られる基板1の外形寸法の情報によって圧 【0018】ここで、上記装置においては、ドーパント 液2の粘度n (Ns/m²)が0.001 (Ns/m²) 以上であって、ノズル径d(μm)が、30-1000 ×n≤d≤34-1000×nの式により規定されてい る必要がある。

【0019】これは本発明者らがインクジェット方式に おけるドーパント液2の塗布試験を繰り返した結果、ド ーパント液2の粘度n(Ns/m²)に対応して、ノズ ル径d(μm)を上記の式を満たすように規定すれば、 安定したドーパント液2の塗布が可能であることを見い 出したためである。この試験結果を以下の表1に示す。 [0020]

【表1】

-	1 / 1	T 100 5 10	<u>, </u>	Lac I		
ドーパント 粘度 n (Ns/.m²)	液の	0.0008	0. 001	0, 002	0.003	0. 004
ノズル径	25	x	×	×	×	×
d	26	×	×	×	×	0
(µ m)	27	×	×	×	0	0
	28	×	×	0	0	0
	29	×	0	0	0	0
	30	×	0	0	0	0
	31	×	0	0	0	×
	32	×	0	0	×	×
	33	×	0	×	×	×
	34	×	×	×	×	×

[0021]

○…安定してドーパント液2を塗布することができた。 ×…安定してドーパント液2を塗布することができなか 40 った。

【0022】ここで、ドーパント液2としては、粘度が 約0.003 (Ns/m^2) のPSG (リン含有シリケートガラス)の液状前駆体が通常好適に用いられるが、 インクヘッドジェット4の温度によって粘度が変化する ため、この試験ではその前後の粘度である0.000 8、0、001、0、002、0、003および0、0 04 (Ns/ m^2) に調整されたPSGの液状前駆体を 用意して行なった。

【0023】また、ノズル6としては、ノズル径dが2※50 02(Ns/m²)未満である場合には安定したドーパ

 $%5\sim34\mu$ mのものまでを 1μ mごとに用意した。

【0024】上記試験の結果、ドーパント液2の粘度 n (Ns/m^2) が0.0008 (Ns/m^2) である場合 には、ノズル径dをどの値のものに設定しても安定した ドーパント液2の塗布をすることができなかった。この 場合にはドーパント液2の粘度が低いため、ノズル6か ら吐出されたドーパント液2は、ノズル面に対して垂直 に飛翔せず、多数の微小な液滴に分裂して広がってスプ ラッシュ状に飛翔してしまうこととなり、基板1上にド ーパント液2を均一に塗布することができなかった。 【0025】尚、ドーパント液2の粘度を上げていった ところ、ドーパント液2の粘度n(Ns/m²)が0.

5

ント液2の塗布をすることができたが、0.02(Ns /m²)以上である場合には、実際上問題ない程度では あるが多少塗布ムラが見られる傾向にあり、また速乾性 も多少劣る傾向にあった。

【0026】したがって、上記試験結果により、本発明 で用いられるドーパント液の粘度n(Ns/m²)は 0.001 (Ns/m²)以上、好ましくは0.001 以上0.02(Ns/m²)未満である。ここで、上述 のように粘度が約0.003 (Ns/m²)のPSG に用いられることを考慮すると、より好ましくは0.0 01 (Ns/m²)以上0.004 (Ns/m²)未満で ある。

【0027】<ドーパント液の塗布>以下、図1におい て、上記製造装置を用いたドーパント液2の基板1上へ の塗布について説明する。

【0028】図1において、インクジェットヘッド4お よび基板形状測定装置5は固定されており、基板チャッ ク3が矢印の方向に進行することに伴い、それに保持さ れた基板1がその方向に進行する。基板1の進行速度と しては一例として200mm/sである。

【0029】基板1はまず基板形状測定装置5の下を通 過し、この通過中に基板1の外形寸法が測定される。次 に基板 1 はインクジェットヘッド 4 の下を通過し、通過 中にインクジェットヘッド4からドーパント液2が基板 1上に塗布される。この塗布の際には、あらかじめ基板 形状測定装置5によって測定された基板1の外形寸法を もとに、基板1の側面または裏面にドーパント液2が回 り込まないようにするため、図3中の領域9にドーパン ト液2が塗布されるように制御されることが好ましい。 【0030】すなわち、基板形状測定装置5は基板1の 外形寸法を測定し、その測定した基板1の外形寸法の情 報をインクジェットヘッド4に伝達し、その伝達された 情報に基づいてインクジェットヘッド4の塗布幅が基板 1の外形寸法に応じて伸縮するように制御される。した がって、ドーパント液2を領域9内に容易に塗布するこ とができる。

【0031】また、領域9は基板1の端部から一例とし て0.1mm離れた長さの位置に設定される。

【0032】ここで、基板1は、図4(a)に表わされ 40 ているように、基板1製造時に生じる表面の加工変質層 を除去するため、あるいは異方性エッチングによって基 板1の表面に微細なピラミッド状の凹凸を含むテクスチ ャ表面を形成するため、水酸化ナトリウムを含む溶液中 に基板 1 を浸漬してエッチング処理されている一辺約1 25mmの略正方形形状のp型多結晶シリコン半導体基 板が用いられている。

【0033】そして、図4(b)に表わされているよう に、上記装置によって、基板1上の領域9にドーパント 液を塗布されることとなる。また、基板1の側面または 50 裏面にドーパント液2が付着しないようにマスクを用い ることもできる。

【0034】上記ドーパント液2の基板1上への塗布後 には、基板1を乾燥し、乾燥後の基板1上に反射防止 膜、電極等を形成して太陽電池が製造される。

【0035】上記実施の形態においては、基板1として 一辺約125mmの略正方形状のp型多結晶シリコン半 導体基板を用いたが、本発明においては寸法、形状、結 晶の種類に左右されずいかなる基板も使用することがで (リン含有シリケートガラス)の液状前駆体が通常好適 10 きる。ただし、丸型基板等の場合には、基板形状測定装 置5を備えていてもインクジェットヘッド4の制御が複 雑になるため、矩形基板あるいは正方形基板を用いるの が好ましい。

> 【0036】また、上記実施の形態においては、基板1 は、基板1の製造時に生じる表面の加工変質層の除去、 あるいは基板1の表面に微細なピラミッド状の凹凸を含 むテクスチャ表面の形成等のため、水酸化ナトリウムを 含む溶液中に浸漬すること等によるエッチング処理等が 行なわれているが、そのエッチング処理等は行なわれて 20 いなくてもよい。

【0037】また、基板1の材質は、特に限定されずい かなる材質も好適に用いることができ、たとえば単結晶 または多結晶のシリコン等を用いることができる。

【0038】また、上記実施の形態においては、ドーパ ント液2の材質はPSGに限定されず、BSG(ホウ素 含有シリケートガラス)等のいかなる材質も好適に用い ることができる。

【0039】また、本願の太陽電池の構造、製造方法お よび製造装置は特に基板表面にドーパント液を塗布する 構造、その製造方法およびその製造装置を特長とするも のであり、これら以外のたとえば反射防止膜、電極等の 構造やその製造方法、製造装置を限定するものではな 14

【0040】今回開示された実施の形態はすべての点で 例示であって制限的なものではないと考えられるべきで ある。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求 の範囲によって示され、特許請求の範囲と均等の意味お よび範囲内でのすべての変更が含まれることが意図され る。

[0041]

【発明の効果】上述のように本発明によれば、塗布ムラ のない安定したドーパント液の基板上への塗布を可能と し、かつ粘度の低いドーパント液を使用することができ るため太陽電池の生産性を向上することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の太陽電池の製造装置の一例の模式的 な斜視図である。

【図2】 本発明で用いられるインクジェットヘッドの 模式的な断面図である。

ドーパント液が塗布される好適な領域の模式 【図3】

的な上面図である。

【図4】 本発明で用いられる基板の模式的な断面図および本発明で用いられるドーパント液塗布後の基板の模式的な断面図である。

7

【図5】 従来のスピン塗布法で用いられる基板の模式 的な断面図および従来のスピン塗布法で用いられるドー パント液が塗布された基板の模式的な断面図である。

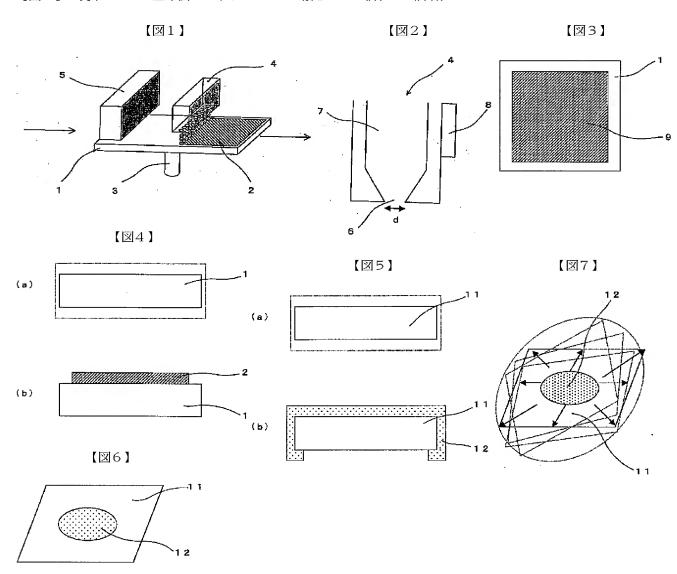
【図6】 従来のスピン塗布法におけるドーパント液を

塗布した後の基板の模式的な斜視図である。

【図7】 従来のスピン塗布法におけるドーパント液を 塗布した後の基板の回転中の模式的な斜視図である。

【符号の説明】

1,11 基板、2,12 ドーパント液、3 基板チャック、4 インクジェットヘッド、5 基板形状測定装置、6 ノズル、7 インキチャンバ、8 圧電素子板、9 領域。



フロントページの続き

Fターム(参考) 4D075 AC07 AC73 AC79 AC93 AC96

CA22 DA06 DB11 DC21 EA07

EA60 EB52 EB60

4F033 AA14 BA03 CA07 DA05 EA01

JA06 NA01

5F051 AA03 CB13 CB18 CB30

DERWENT-ACC-NO: 2003-650059

DERWENT-WEEK: 200362

COPYRIGHT 2010 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Solar cell manufacturing apparatus includes

inkjet head whose nozzle diameter satisfies preset relationship with respect to viscosity of dopant

liquid

INVENTOR: IMANAKA T

PATENT-ASSIGNEE: SHARP KK[SHAF]

PRIORITY-DATA: 2001JP-366940 (November 30, 2001)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO PUB-DATE LANGUAGE

JP 2003168810 A June 13, 2003 JA

APPLICATION-DATA:

PUB-NO APPL-DESCRIPTOR APPL-NO APPL-DATE

JP2003168810A N/A 2001JP- November 30,

366940 2001

INT-CL-CURRENT:

TYPE IPC DATE

CIPP B05D7/00 20060101 CIPS B05B1/14 20060101 CIPS H01L21/225 20060101 CIPS H01L31/04 20060101

ABSTRACTED-PUB-NO: JP 2003168810 A

BASIC-ABSTRACT:

NOVELTY - An inkjet head (4) that supplies a dopant liquid (2) on the surface of a silicon substrate (1), has a nozzle whose diameter d' is maintained between (30-1000xn) to (34-1000xn), where n' is the viscosity of the dopant liquid at the time of application. The viscosity ranges between 0.001-0.02 Nsec/m2.

DESCRIPTION - An INDEPENDENT CLAIM is also included for solar cell manufacturing method.

USE - For use in the manufacture of solar cell (claimed) using inkjet system.

ADVANTAGE - Enables applying the dopant liquid stably and uniformly, thereby improving the production of the solar cell.

DESCRIPTION OF DRAWING(S) - The figure shows a perspective view of the solar cell manufacturing apparatus.

substrate (1)

dopant liquid (2)

substrate chuck (3)

inkjet head (4)

CHOSEN-DRAWING: Dwg.1/7

TITLE-TERMS: SOLAR CELL MANUFACTURE

APPARATUS HEAD NOZZLE DIAMETER SATISFY PRESET RELATED RESPECT

VISCOSITY DOPE LIQUID

DERWENT-CLASS: P42 T04 U11 U12

EPI-CODES: T04-G02A1; U11-C02A1; U12-A02A3;

SECONDARY-ACC-NO:

Non-CPI Secondary Accession Numbers: 2003-517101